



三洋半導体  
ニュース

No.1400  
8043

2SC3485

シリコン NPN 三重放射アレーナ型トランジスタ

高精細度CRTディスプレイ水平偏向出力用

特長 ・高耐圧、高信頼性である。

- ・スイッチングスピードが速い:  $t_f=0.3\mu s \text{ max.}$
- ・一点止め樹脂モールドパッケージで 取り付け作業性が良い。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^\circ C$

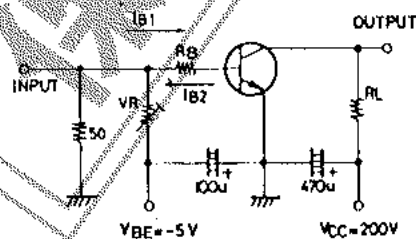
|             |           |                         | unit       |
|-------------|-----------|-------------------------|------------|
| コレクタ-ベース電圧  | $V_{CB0}$ | 1500                    | V          |
| コレクタ-エミッタ電圧 | $V_{CE0}$ | 800                     | V          |
| エミッタ-ベース電圧  | $V_{EB0}$ | 7                       | V          |
| コレクタ電流      | $I_C$     | 5                       | A          |
| ピークコレクタ電流   | $i_{cP}$  | 16                      | A          |
| コレクタ損失      | $P_C$     | $T_C=25^\circ C$<br>120 | W          |
| 接合部温度       | $T_j$     | 150                     | $^\circ C$ |
| 保存周囲温度      | $T_{stg}$ | -55~+150                | $^\circ C$ |

電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^\circ C$

|               |               |                                 | min  | typ | max | unit    |
|---------------|---------------|---------------------------------|------|-----|-----|---------|
| コレクタシャ断電流     | $I_{CBO}$     | $V_{CB}=800V, I_E=0$            |      |     | 10  | $\mu A$ |
| エミッタシャ断電流     | $I_{EBO}$     | $V_{EB}=5V, I_C=0$              |      |     | 1   | mA      |
| 直流電流増幅率       | $h_{FE}$      | $V_{CE}=5V, I_C=1A$             | 8    |     |     |         |
| 利得帯域幅積        | $f_T$         | $V_{CE}=10V, I_C=1A$            |      | 3   |     | MHz     |
| コレクタ-エミッタ飽和電圧 | $V_{CE(sat)}$ | $I_C=4A, I_B=1A$                |      |     | 5   | V       |
| ベース-エミッタ飽和電圧  | $V_{BE(sat)}$ | $I_C=4A, I_B=1A$                |      |     | 1.5 | V       |
| コレクタ-ベース降伏電圧  | $V(BR)_{CBO}$ | $I_C=5mA, I_E=0$                | 1500 |     |     | V       |
| コレクタ-エミッタ降伏電圧 | $V(BR)_{CEO}$ | $I_C=5mA, I_{BE}=\infty$        | 800  |     |     | V       |
| エミッタ-ベース降伏電圧  | $V(BR)_{EBO}$ | $I_E=5mA, I_C=0$                | 7    |     |     | V       |
| 蓄積時間          | $t_{stg}$     | $I_C=4A, I_B=0.8A,$             |      |     | 3.0 | $\mu s$ |
| 下降時間          | $t_f$         | $I_B2=-1.6A,$<br>$R_L=50\Omega$ |      |     | 0.3 | $\mu s$ |

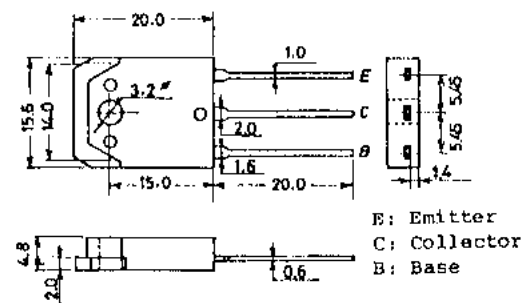
スイッチングタイム測定回路

$PW=20\mu s, Duty \leq 1\%$



外形図 2022

(unit:mm)

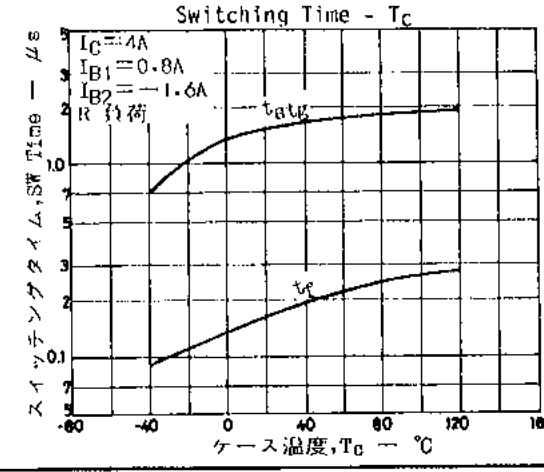
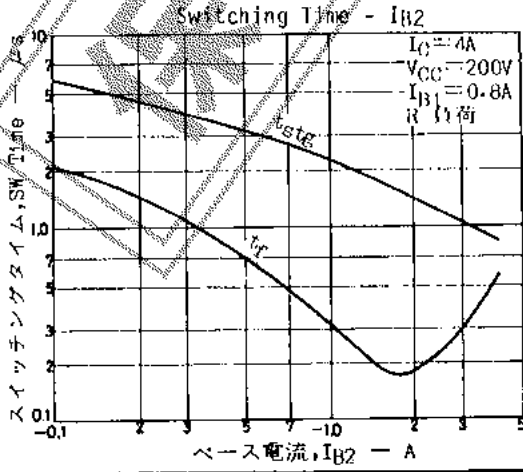
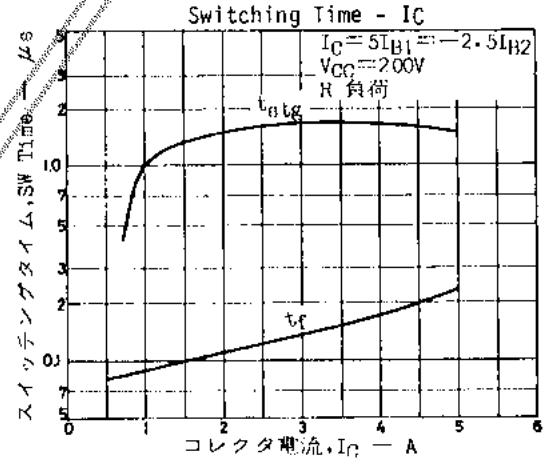
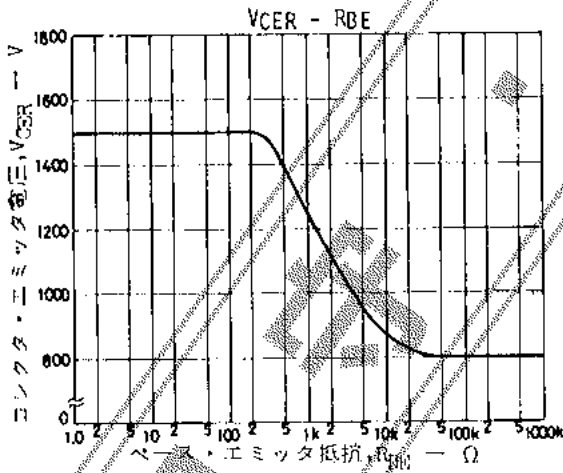
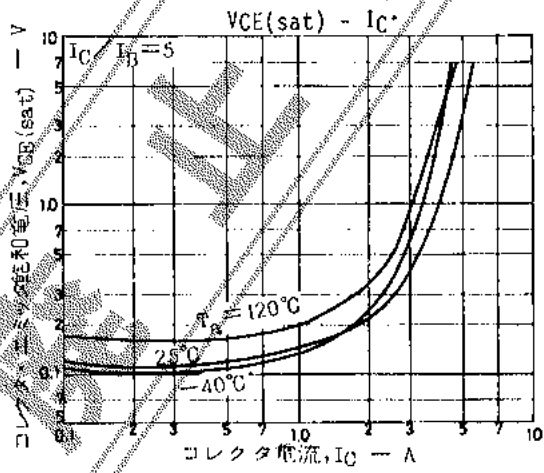
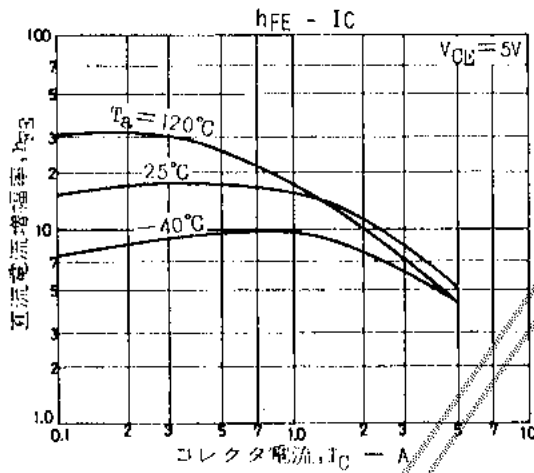
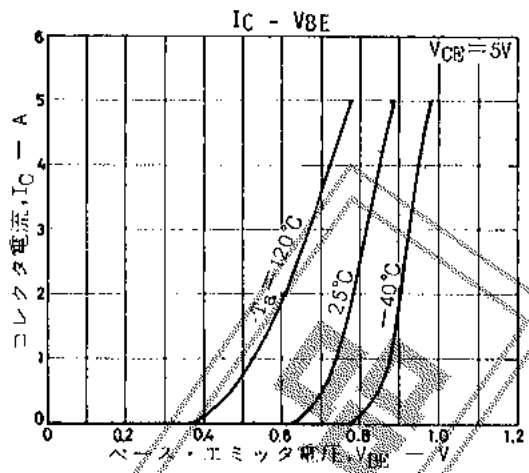
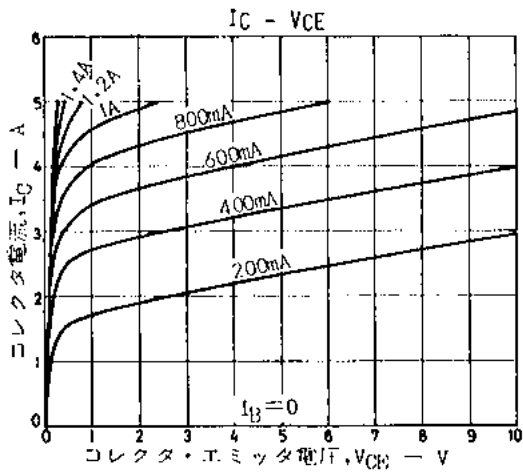


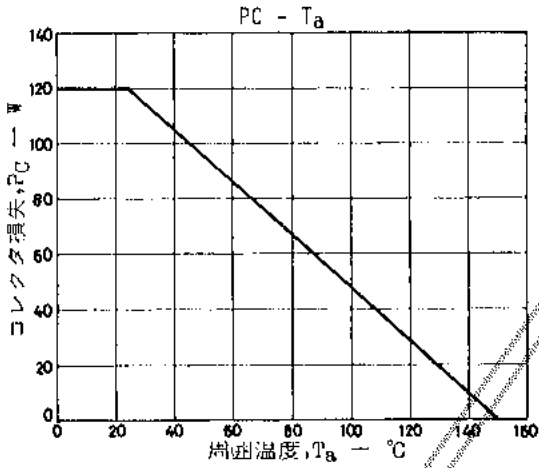
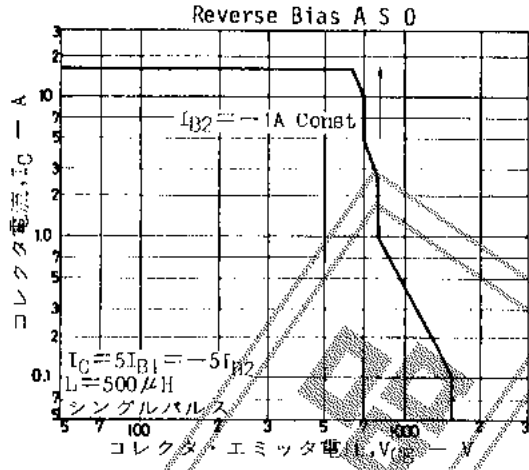
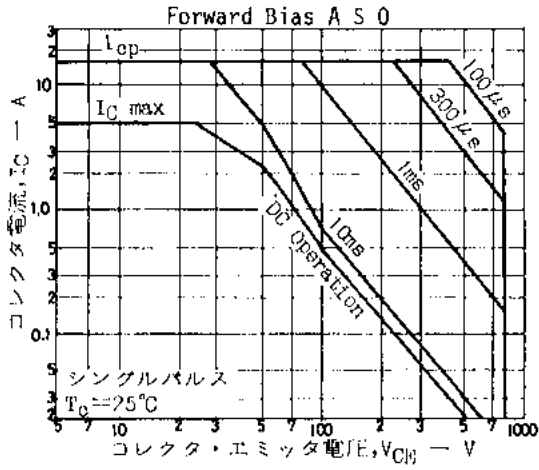
\* これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。

〒370-05 群馬県大泉町城田180

東京三洋電機(株)半導体事業部

TEL 0276 63-2111 (大代表)





■特許の非保証について：  
この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しております。ただしその使用にあたって、工業所有権その他の権利の実施に対する保証、または実施権の許諾を有するものではありません。

Information furnished by SANYO is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by SANYO for its use; nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use, and no license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of SANYO.

